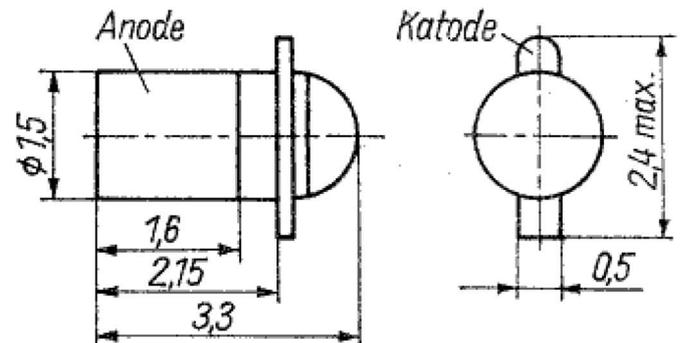


# VQ 120

GaAs-Infrarot-Emitterdiode in Metall-Keramik-Gehäuse mit linsenförmigem Glasfenster.

Durch ihre äußeren Abmessungen ist der Aufbau von Emitterdiodenzeilen und -matrizen mit einem Rastermaß von 2,5 mm möglich. Bauform und Abmessungen stimmen annähernd mit denen des Fototransistors SP 211 überein.

Bauform 14



**Grenzwerte bei  $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$**

		min	typ	max	
Durchlaßgleichstrom	$I_F$	—	—	100	mA
Sperrgleichspannung	$U_R$	—	—	2	V
Betriebstemperatur	$\vartheta_a$	-65	—	100	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	$\vartheta_{\text{stg}}$	-65	—	125	$^\circ\text{C}$

**Kennwerte bei  $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$**

Durchlaßgleichspannung $I_F = 50\text{ mA}$	$U_F$	—	1,25	1,5	V
Diff. Widerstand $I_F = 50\text{ mA}$	$r_f$	—	1,2	—	$\Omega$
Sperrgleichstrom $U_R = 2\text{ V}$	$I_R$	—	—	100	$\mu\text{A}$
Strahlungsleistung $I_F = 50\text{ mA}, t_p = 50\text{ ms}$					
VQ 120 A	$P_e$	400	600	—	$\mu\text{W}$
VQ 120 B	$P_e$	700	900	—	$\mu\text{W}$
VQ 120 C	$P_e$	1 000	1 350	—	$\mu\text{W}$
Wellenlänge der max. Emission $I_F = 50\text{ mA}$	$\lambda_p$	915	940	975	nm
Spektrale Halbwertsbreite $I_F = 50\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	—	55	75	nm
Schaltzeiten bei $I_{FRM} = 100\text{ mA}$					
Anstiegszeit	$t_r$	—	0,6	2	$\mu\text{s}$
Abfallzeit	$t_f$	—	0,5	2	$\mu\text{s}$